

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019589

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	M. Tamura et al., Secondary Defects in 1-10 keV As- and BF ₂ -implanted Si, 1998 International Conference on Ion Implantation Technology Proceedings, pages 744 to 747	1-17
A	H.C. -H. Wang et al., substrate-Strained Silicon Technology: Process Integration, IEDM 2003, pages 61 to 64	1-17
A	JP 2000-286418 A (Hitachi, Ltd.), 13 October, 2000 (13.10.00), Full text; all drawings & WO 2000/060671 A1 & AU 200033306 A & EP 1174928 A1 & KR 2001110690 A & CN 1349662 A & TW 557577 A	1-17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
29 March, 2005 (29.03.05)

Date of mailing of the international search report
19 April, 2005 (19.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019589

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-270685 A (Sony Corp.), 09 October, 1998 (09.10.98), Full text; all drawings & US 2004/0135210 A1	1-17
A	US 2003/0227029 A1 (AMBERWAVE SYSTEMS CORP.), 11 December, 2003 (11.12.03), Full text; all drawings & WO 2003/105233 A1 & AU 2003247493 A1	1-17
A	JP 2001-217433 A (Samsung Electronics Co., Ltd.), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; all drawings & US 2003/0227029 A1 & GB 2365214 A & DE 10100194 A1 & KR 2001070298 A & CN 1322016 A & TW 506076 A & US 6633066 B1 & US 2004/0075143 A1	1-17
A	J.L. Hoyt et al., Strained Silicon MOSFET Technology, IEDM 2002, pages 23 to 26	1-17
A	JP 10-106966 A (Nippon Steel Corp.), 24 April, 1998 (24.04.98), Full text; all drawings (Family: none)	1-17
A	JP 10-214906 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 11 August, 1998 (11.08.98), Par. No. [0154] & EP 829908 A2 & KR 98024649 A & US 2002/0011617 A1 & DE 69711138 E & US 2002/0105015 A1 & JP 2002-198533 A & JP 2002-203912 A & JP 2003-60078 A & US 6190975 B1	1-17

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int.Cl. ⁷ H01L29/78, H01L21/336; H01L29/786		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int.Cl. ⁷ H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	M. Tamura et al., Secondary Defects in 1-10 keV As- and BF ₂ -implanted Si, 1998 International Conference on Ion Implantation Technology Proceedings, pp. 744-747	1-17
A	H. C.-H. Wang et al., Substrate-Strained Silicon Technology: Process Integration, IEDM 2003, pp. 61-64	1-17
A	JP 2000-286418 A (株式会社日立製作所) 2000.10.13, 全文, 全図 &WO 2000/060671 A1 &AU 200033306 A &EP 1174928 A1 &KR 2001110690 A &CN 1349662 A &TW 557577 A	1-17
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 29.03.2005	国際調査報告の発送日 19.4.2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 松嶋 秀忠	4 M 9836
電話番号 03-3581-1101 内線 3460		

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 10-270685 A(ソニー株式会社) 1998. 10. 09, 全文, 全図 &US 2004/0135210 A1	1-17
A	US 2003/0227029 A1(AMBERWAVE SYSTEMS CORPORATION) 2003. 12. 11, 全文, 全図 &WO 2003/105233 A1 &AU 2003247493 A1	1-17
A	JP 2001-217433 A(三星電子株式会社) 2001. 08. 10, 全文, 全図 &US 2003/0227029 A1 &GB 2365214 A &DE 10100194 A1 &KR 2001070298 A &CN 1322016 A &TW 506076 A &US 6633066 B1 &US 2004/0075143 A1	1-17
A	J.L.Hoyt et al., Strained Silicon MOSFET Technology, IEDM 2002, pp.23-26	1-17
A	JP 10-106966 A(新日本製鐵株式会社) 1998. 04. 24, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-17
A	JP 10-214906 A(松下電器産業株式会社) 1998. 08. 11, 【0154】 &EP 829908 A2 &KR 98024649 A &US 2002/0011617 A1 &DE 69711138 E &US 2002/0105015 A1 &JP 2002-198533 A &JP 2002-203912 A &JP 2003-60078 A &US 6190975 B1	1-17